

А. Г. РАММ

ПРИБЛИЖЕННЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ТЕНЗОРА ПОЛЯРИЗУЕМОСТИ И ЕМКОСТИ ТЕЛ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ И НЕКОТОРЫЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

(Представлено академиком В. А. Фоком 4 V 1970)

В п. 1 приводится формула для тензора поляризуемости однородного диэлектрического тела D с постоянной ε_i , помещенного в среду с постоянной ε_e . В п. 2 дана формула для электростатической емкости проводника произвольной формы. В п. 3 рассмотрены приложения.

1. Тензор поляризуемости тела будем обозначать $\alpha_{ij}(\gamma)$, где $\gamma = (\varepsilon_i - \varepsilon_e) / (\varepsilon_i + \varepsilon_e)$. Пусть V — объем тела D . Тогда при внесении его во внешнее электростатическое постоянное поле E это тело приобретает дипольный момент

$$P_i = \sum_{j=1}^3 \alpha_{ij}(\gamma) V E_j. \quad (1)$$

Через Γ обозначается поверхность тела D , $N_i(s)$ — компонента внешней к поверхности Γ нормали, проходящей через точку s , $r_{st} = |s - t|$ — расстояние между точками s и t .

Положим

$$\alpha_{ij}^{(n)}(\gamma) = \frac{2}{V} \sum_{m=0}^n M_{ij}^{(m)} \frac{(-1)^m}{(2\pi)^m} \frac{\gamma^{n+2} - \gamma^{m+1}}{\gamma - 1}, \quad (2)$$

где

$$M_{ij}^{(0)} = V \delta_{ij}, \quad M_{ij}^{(1)} = \iint_{\Gamma} \iint_{\Gamma} \frac{N_i(s) N_j(t)}{r_{st}} ds dt, \quad (3)$$

$$M_{ij}^{(m)} = \iint_{\Gamma} \iint_{\Gamma} ds dt N_i(s) N_j(t) \underbrace{\int_{\Gamma} \dots \int_{\Gamma}}_{m-1 \text{ раз}} \frac{1}{r_{s'm-1t}} \psi(t_1, t) \psi(t_2, t_1) \dots \dots \psi(t_{m-1}, t_{m-2}) dt_1 \dots dt_{m-1}. \quad (3a)$$

Здесь использовано обозначение

$$\psi(t, s) = \frac{\partial}{\partial N_t} \frac{1}{r_{st}}. \quad (4)$$

Величина $\alpha_{ij}^{(n)}(\gamma)$ является n -м приближением тензора $\alpha_{ij}(\gamma)$.

Т е о р е м а 1. *Имеет место оценка*

$$|\alpha_{ij}^{(n)}(\gamma) - \alpha_{ij}(\gamma)| \leq A q^{n+1}, \quad (5)$$

в которой $0 < q < 1$. Постоянные A и q определяются только формой поверхности и числом γ .

З а м е ч а н и е 1. Для сферы $A = 1$, $q = 1/3$.

З а м е ч а н и е 2. При $\varepsilon_i = \infty$, $\gamma = 1$, что соответствует идеальной проводимости тела D , формула (2) примет вид:

$$\alpha_{ij}^{(n)} = \frac{2}{V} \sum_{m=0}^n M_{ij}^{(m)} \frac{(-1)^m}{(2\pi)^m} (n + 1 - m). \quad (6)$$

При $\varepsilon_i = 0$, $\gamma = -1$, что соответствует идеальному магнетику, формула (2) примет вид

$$\beta_{ij}^{(n)} = \frac{-1}{V} \sum_{m=0}^n M_{ij}^{(m)} \frac{1 + (-1)^{m+n}}{(2\pi)^m}. \quad (7)$$

Магнитный момент тела D в постоянном внешнем поле H вычисляется по формуле

$$M_i = \sum_{j=1}^3 \beta_{ij} V H_j. \quad (1a)$$

2. Обозначим через C электростатическую емкость проводника D . Введем величину

$$C^{(n)} = 4\pi S^2 \int \left(-\frac{1}{2\pi} \right)^n \iint_{\Gamma} \frac{ds dt}{r_{st}} \underbrace{\int_{\Gamma} \dots \int_{\Gamma}}_{n \text{ раз}} \psi(t, t_n) \psi(t_n, t_{n-1}) \dots \psi(t_2, t_1) dt_1 \dots dt_n. \quad (8)$$

Здесь S — площадь поверхности Γ , а функция $\psi(t, s)$ определена формулой (4). Величину $C^{(n)}$ можно рассматривать как n -е приближение к емкости проводника.

Теорема 2. *Имеет место оценка*

$$|C^{(n)} - C| \leq A_1 q^{n+1}, \quad (9)$$

в которой $0 < q < 1$. Постоянные A_1 , q определяются только формой поверхности и числом γ .

Замечание 3. Число q в теоремах 1, 2 одно и то же.

Замечание 4. При $n=0$ формула (8) принимает особенно простой вид:

$$C^{(0)} = 4\pi S^2 \int \int_{\Gamma} \frac{ds dt}{r_{st}}. \quad (10)$$

Формула (10) по существу является аналитической записью известного эмпирического рецепта Хоу вычисления емкости.

Доказательства теорем 1, 2 основаны на методах, развитых в работах (1).

3. а) Характеристика рассеяния на малом теле D в предположении, что магнитным дипольным излучением можно пренебречь, имеет вид

$$f = b [\mathbf{v} [P, \mathbf{v}]], \quad b = k_0^2 / 4\pi \varepsilon_0. \quad (11)$$

Здесь ε_0 — диэлектрическая постоянная среды, k_0 — волновое число, \mathbf{v} — орт, направленный на точку наблюдения, P — дипольный момент малого тела в постоянном электростатическом поле E , которое совпадает с значением электрического вектора падающего электромагнитного поля в точке нахождения малого тела. Заметим, что если размеры тела малы по сравнению с длиной волны падающего поля, то положение тела можно характеризовать координатами одной точки.

Задача, которая нас интересует, состоит в следующем. Можно ли вычислить вектор первичного поля E в точке нахождения малого тела, если известна характеристика рассеяния на этом теле? Ответ на этот вопрос положительный. Для доказательства рассмотрим линейную систему с самосопряженной матрицей:

$$\sum_{m=1}^3 a_{im} E_m = J_i, \quad 1 \leq i \leq 3; \quad a_{im} = \sum_{j=1}^3 bV (\delta_{ij} - v_i v_j) \alpha_{jm}. \quad (12)$$

Тензор α_{ij} определяется геометрией тела и может быть вычислен по формуле (2). Оказывается, что система (12) имеет ранг 2. Сопряженная однородная система (12) имеет собственный вектор v . Свободный член удовлетворяет условию $(f, v) = 0$, где скобки означают скалярное произведение. Это условие гарантирует разрешимость системы (12). Расчетный алгоритм нахождения первичного поля E сводится к следующему:

1) Находим решение G_1 системы (12) при $v = v_1, f_i = f_i(v_1)$, где v_1 — произвольный орт, удовлетворяющее условию $(G_1, v_1) = 0$. Такое решение существует и единственно.

2) Находим решение G_2 системы (12) при $v = v_2, f_i = f_i(v_2)$, где v_2 — любой орт, перпендикулярный орту v_1 , удовлетворяющее условию $(G_2, v_2) = 0$.

3) Находим E по формуле $E = G_1 + (G_2, v_1)v_1$, или по формуле $E = G_2 + (G_1, v_2)v_2$.

Действительно, $G_j = E - (E, v_j)v_j, j = 1, 2$. Поэтому $G_1 + (E, v_1)v_1 = G_2 + (E, v_2)v_2$. Отсюда следуют равенства $(G_2, v_1) = (E, v_1), (G_1, v_2) = (E, v_2)$, которые приводят к формулам 3) алгоритма.

Нетрудно составить алгоритм вычисления поля E по значениям вектора рассеянного поля, измеренным в двух любых непараллельных направлениях v_1, v_2 (не обязательно перпендикулярных).

б) С помощью теоремы 1 можно написать главный член характеристики рассеяния на теле, малом по сравнению с длиной волны падающего поля. Достаточно в известное выражение (см. например, (16), стр. 1192)

$$f_E = \frac{k_0^2}{4\pi} \left\{ \frac{1}{\epsilon_0} [v[P, v]] - \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} [v, M] \right\} \quad (13)$$

подставить вместо P и M их значения по формулам (1), (1а). В формуле (13) ϵ_0, μ_0 — параметры среды, $k_0^2 = \omega^2 \epsilon_0 \mu_0$, v — орт, направленный на точку наблюдения, P, M — дипольные электрические и магнитные моменты, приобретенные телом в статических электрическом E и магнитном M полях. Поля E, H совпадают с значениями электрического и соответственно магнитного вектора падающего поля в точке нахождения малого тела.

в) В книге (2) изложена теория рассеяния света на малых частицах главным образом эллипсоидальной формы. Результаты п. 1 позволяют развить эту теорию для частиц произвольной формы, что представляет интерес, например, для атмосферной оптики, коллоидной химии, астрофизики, теории радиоизмерений. Рассеяние на больших телах произвольной формы изучено В. А. Фоком (3).

г) Рассмотрим скалярную задачу об определении формы выпуклого отражающего тела по характеристике рассеяния:

$$f(n, v, k) = -\frac{1}{4\pi} \int_{\Gamma} \exp\{-ik(v, s)\} \frac{\partial u}{\partial N} ds. \quad (14)$$

Здесь n, v — направление распространения падающей и рассеянной волны соответственно. В коротковолновом приближении

$$\frac{\partial u}{\partial N} \Big|_{\Gamma_-} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial N} \Big|_{\Gamma_+} = 2 \frac{\partial}{\partial N} \exp\{ik(n, s)\}.$$

Здесь Γ_+, Γ_- — освещенная и теневая части поверхности Γ . В этом приближении формула (14) примет вид

$$f(n, v, k) = \frac{k}{2\pi i} \int_{\Gamma_+} \exp\{-ik(v - n)(l, s)\} (n, N_s) ds, \quad l \equiv \frac{v - n}{|v - n|}. \quad (15)$$

Вычисляя интеграл при $k \rightarrow \infty$ методом стационарной фазы, получим

$$f(n, k, v) \simeq -1/2\mathcal{K}(l), \quad \mathcal{K}(l) = 1/\sqrt{R_l R_{-l}}. \quad (16)$$

Эту формулу можно вывести другим способом исходя из общих результатов ⁽²⁾. Здесь $\mathcal{K}(l)$ — гауссова кривизна поверхности в той точке, нормаль к которой совпадает с ортом l . По теореме Минковского ⁽⁴⁾ задание гауссовой кривизны как функции внешней нормали однозначно определяет выпуклую поверхность. Следовательно, зная, например, функцию $f(n, -n, k)$ при всех n и $k \rightarrow \infty$, можно восстановить форму отражающего тела. Эффективный способ восстановления основан на следующих соображениях.

Из формулы (15) следует равенство

$$f(n, v, k) + f^*(-n, -v, k) = \frac{k}{2\pi i} \int_{\Gamma} \exp\{-ik(v, -n, s)\} (n, N_s) ds = \frac{1 - (v, n)}{2\pi} k^2 \int_D \exp\{-ik|n - v|(l, y)\} dy. \quad (17)$$

Пользуясь асимптотической формулой ⁽⁵⁾, стр. 42)

$$\int_D e^{ik(l, v)} dy = -\frac{4\pi}{\mathcal{K}(l)} \frac{\cos\{ka(l)\}}{k^2} \left(1 + O\left(\frac{1}{\sqrt{k}}\right)\right), \quad k \rightarrow +\infty, \quad (18)$$

где $a(l)$ — полуширина выпуклого центрально симметричного тела D в направлении l , получаем из формулы (17) при $k \rightarrow \infty$ следующее асимптотическое равенство, вычисленное в системе координат, начало которой помещено в центр симметрии тела D , а ось z которой направлена вдоль вектора l :

$$f(n, v, k) + f^*(-n, -v, k) = -\cos\{k_1 a(l)\} / \mathcal{K}(l), \quad k_1 = k|n - v|, \quad k \rightarrow \infty. \quad (19)$$

Выражение (19) определяет функцию $a(l)$. Зная эту функцию, нетрудно написать параметрическое уравнение поверхности Γ ⁽⁴⁾, стр. 168):

$$x = \partial a / \partial \alpha, \quad y = \partial a / \partial \beta, \quad z = \partial a / \partial \gamma, \quad (20)$$

где α, β, γ — проекции орта l на декартовы оси.

Отметим, что функция $a(l)$ — опорная функция выпуклой поверхности — является однородной функцией α, β, γ порядка 1 ⁽⁴⁾.

В заключение приношу искреннюю благодарность акад. В. А. Фоку за интерес к работе и ценные советы.

Ленинградский институт
точной механики и оптики

Поступило
21 IV 1970

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ¹ А. Г. Рамм, а) ДАН, 186, № 1, 62 (1969); б) Радиофизика, Изв. высш. учебн. завед., 12, № 8, 1185 (1969). ² Г. Ван де Хюлст, Рассеяние света малыми частицами, ИЛ, 1961. ³ В. А. Фок, а) Изв. АН СССР, сер. физич., 10, № 2, 171 (1946); б) УФН, 36, № 3, 308 (1948). ⁴ В. Бляшке, Круг и шар, М., 1967. ⁵ И. М. Гельфанд, М. И. Граев, Н. Я. Виленики, Интегральная геометрия и связанные с ней вопросы теории представлений, М., 1962. ⁶ А. Г. Рамм, а) Радиотехника и электроника, 10, № 11, 2062 (1965); б) III Всесоюз. симпозиум по дифракции поля. Реф. докл., «Наука», 1964, стр. 143.